

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002 年 10 月 10 日 (10.10.2002)

PCT

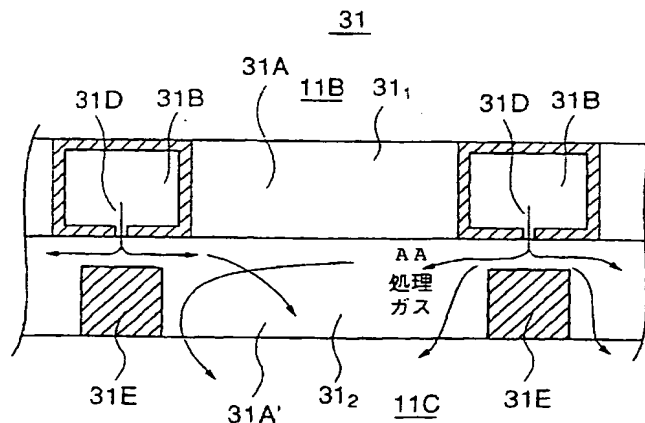
(10) 国際公開番号  
WO 02/080249 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/31, 21/3065, H05H 1/46 (71) 出願人 および  
(72) 発明者: 大見 忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒980-0813 宮城県 仙台市 青葉区 米ヶ袋 2 丁目 1-17-301 Miyagi (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/03108
- (22) 国際出願日: 2002 年 3 月 28 日 (28.03.2002) (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平山 昌樹 (HIRAYAMA, Masaki) [JP/JP]; 〒980-8579 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻字青葉 05 東北大学大学院工学研究科電子工学専攻内 Miyagi (JP). 須川 成利 (SUGAWA, Shigetoshi) [JP/JP]; 〒980-8579 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻字青葉 05 東北大学大学院工学研究科電子工学専攻内 Miyagi (JP). 後藤 哲也 (GOTO, Tetsuya) [JP/JP]; 〒980-8579 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻字青葉 05 東北大学大学院工学研究科電子工学専攻内 Miyagi (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2001-094272 2001 年 3 月 28 日 (28.03.2001) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 伊東 忠彦 (ITO, Tadahiko); 〒150-6032 東京都 渋谷区 恵比寿 4 丁目 2 番 3 号 恵比寿ガーデンプレスタワー 32 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: PLASMA PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: プラズマ処理装置



AA...PROCESSING GAS

(57) Abstract: A plasma processing device comprises a processing vessel defined by an outer wall and having a holding block for holding a board to be processed, an exhaust system connected to the processing vessel, a plasma gas feed section for feeding plasma gas to the processing vessel, a microwave antenna installed on the processing vessel in opposed relation to the board to be processed, a processing gas feeding section disposed between the board to be processed on the holding block and the plasma gas feeding section in opposed relation to the board to be processed, wherein the processing gas feeding section comprises a plurality of first openings formed in the processing vessel to allow the plasma gas to pass therethrough, a processing gas passageway adapted to be connected to a processing gas source, a plurality of second openings communicating with the processing gas passageway, a diffusion section disposed in opposed relation to the second openings for diffusing the processing gas which is discharged through the second openings.

[続葉有]

WO 02/080249 A1

BEST AVAILABLE COPY



(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

プラズマ処理装置は、外壁により画成され、被処理基板を保持する保持台を備えた処理容器と、前記処理容器に結合された排気系と、前記処理容器中にプラズマガスを供給するプラズマガス供給部と、前記処理容器上に、前記被処理基板に対応して設けられたマイクロ波アンテナと、前記保持台上の被処理基板と前記プラズマガス供給部との間に、前記被処理基板に対面するように設けられた処理ガス供給部とよりなり、前記処理ガス供給部は、前記処理容器内に形成されたプラズマを通過させる複数の第1の開口部と、処理ガス源に接続可能な処理ガス通路と、前記処理ガス通路に連通した複数の第2の開口部と、前記第2の開口部に対向して設けられ、前記第2の開口部より放出される処理ガスを拡散させる拡散部とを備えた構成する。